

특징	이점
GaN FET의 조정 가능한속도 켜기/끄기	EMI 테스트 및 솔루션 운영의 유연성 향상
외부 VDD 선형 조정기 회로가 필요하지 않음	부품 수 감소
감소된 패키지 기생 성분(인덕턴스, 저항, 커패시턴스)	칩 성능 극대화
700V 울트라 HV 시동 전류는 AC 주 전압의 라인/중성선에서 직접 제공	부품 수 감소
PWM 칩 추가에도 불구하고 8x8 QFN 패키지에 적합	로우 프로파일/소형 시스템 설치 공간 허용